

Intel produit les premières mémoires Flash NOR 65nm

Présente au cœur des terminaux de poche, assistants numériques et téléphone mobile, la mémoire Flash définit un modèle d'architecture.

Avec la production de puces de mémoire flash NOR multiniveau MLC (*Multi-Level Cell*) d'une densité de 1 gigabit à l'aide de son procédé de gravure en 65 nanomètres, Intel va ainsi permettre l'adoption d'une architecture commune pour simplifier le passage du 90 nm au 65 nm. Intel donne ainsi un coup d'accélérateur aux technologies 65 nm embarquées. La gravure de processeurs à cette taille n'a débuté qu'au second semestre 2005. Elle apparaît sur les PC et serveurs, et sur les ordinateurs portables. Le 65 nm devrait donc rapidement s'approprier le marché de la téléphonie mobile. L'objectif avec cette technologie ne sera pas de réduire la taille des appareils, mais plutôt d'augmenter leurs capacités dans un volume équivalent : réduction de la consommation, liaison sans fil, multimédia, bureautique, etc. « Avec ces produits, Intel continue de proposer les mémoires flash NOR les plus perfectionnées sur le créneau des téléphones mobiles », a déclaré Brian Harrison, vice-président d'Intel et general manager du Flash Memory Group d'Intel. « Notre procédé de gravure en 65 nm améliorera les performances des mémoires flash et se mettra au service d'une nouvelle génération de téléphones mobiles qui procureront aux utilisateurs des fonctionnalités améliorées pour certaines et inédites pour d'autres. »